

圖 6-31 ILD 之形成。

(2) Contact 之微影及蝕刻，接著再把光阻移除，如圖 6-32 所示。

(3)以濺鍍的方式先沉積一層薄的Ti作為黏合層（adhesion layer），再將TiN沉積於Ti之上，作為之後鎢（W）金屬沉積的擴散阻擋層（barrier layer），然後以CVD的方式將鎢金屬沉積上去，如圖 6-33 所示。而Contact採用鎢金屬的原因，是因為此處的截面積很小導致電流密度很大，容易發生電子遷移（Electromigration, EM）。故雖然鎢的阻值很高，但為了防止電子遷移，仍使用之。

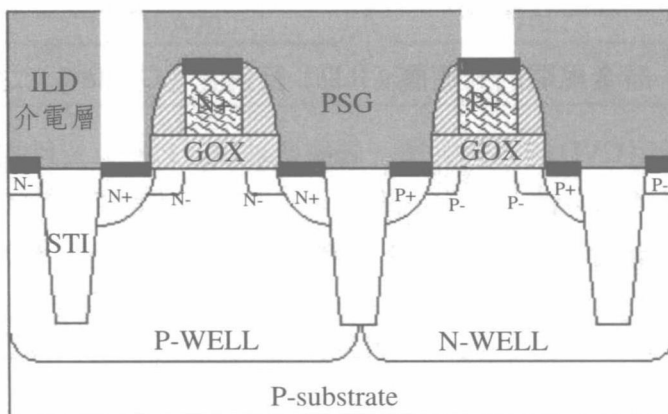


圖 6-32 Contact 之形成。